# MBR20045CT thru **MBR200100CTR**

# Silicon Schottky Diode, 200A

#### **Features**

- **Guard Ring Protection**
- Low forward voltage drop
- High surge current capability
- Up to 100V  $V_{\text{RRM}}$





TWIN TOWER PACKAGE

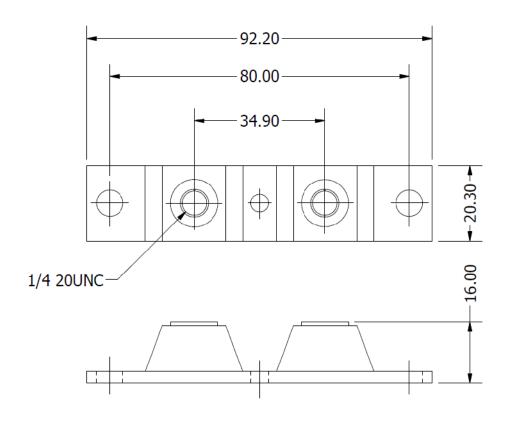
Maximum Ratings (T <sub>J</sub> = 25°C unless otherwise specified)							
Parameter	Symbol	Conditions	MBR20045CT (R)	MBR20060CT (R)	MBR20080CT (R)	MBR200100C T(R)	Units
Repetitive peak reverse voltage	$V_{RRM}$		45	60	80	100	V
RMS reverse voltage	$V_{RMS}$		32	42	56	70	V
DC blocking voltage	$V_{DC}$		45	60	80	100	V
Average forward current	I <sub>F(AV)</sub>	T <sub>C</sub> ≤ 135 °C	200	200	200	200	Α
Non-repetitive forward surge current, half sine- wave	I <sub>FSM</sub>	$T_{c} = 25 ^{\circ}\text{C}$ $t_{p} = 8.3 \text{ms}$	1500	1500	1500	1500	А

Electrical Characteristics (T <sub>J</sub> = 25°C unless otherwise specified)							
Parameter	Symbol	Conditions	MBR20045CT (R)	MBR20060CT (R)	MBR20080CT (R)	MBR200100C T(R)	Units
DC forward voltage	V <sub>F</sub>	$I_F = 100 \text{ A}$ $T_J = 25  ^{\circ}\text{C}$	0.68	0.76	0.88	0.88	٧
DC reverse current	I <sub>R</sub>	$V_R = 20 \text{ V}$ $T_J = 25  ^{\circ}\text{C}$	5	5	5	5	m 1
		$V_R = 20 \text{ V}$ $T_J = 125^{\circ}\text{C}$	200	200	200	200	mA

<b>Thermal Characteristics</b> (T <sub>J</sub> = 25°C unless otherwise specified)							
Parameter	Symbol		MBR20045CT (R)	MBR20060CT (R)	MBR20080CT (R)	MBR200100C T(R)	Units
Thermal resistance junction to case	R <sub>thJ-C</sub>		0.5	0.5	0.5	0.5	°C/W
Operating, storage temperature range	T <sub>J</sub> , T <sub>stg</sub>		- 40 to +175	°C			



## **Package Outline**



**ALL DIMENSIONS IN MM** 

# **Ordering Table**

MBR	200	20	СТ
1	2	3	4

- 1 Device Type
  - > MBR = Schottky Barrier Diode Module
- $2 Current Rating = I_{F(AV)}$
- $3 Voltage = V_{RRM}$
- 4 Polarity
  - > CT = Normal (Cathode to Base)
  - > CTR = Reverse (Anode to Base)

## **ПОСТАВКА** ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001 Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

# Данный компонент на территории Российской Федерации Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

### http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

#### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г. Москва, ул. Щербаковская д. 3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru moschip.ru\_6 moschip.ru\_4 moschip.ru\_9